

EIC06DFN-TVS430

TVS芯片

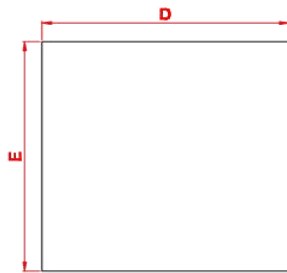


EIC06DFN-TVS430

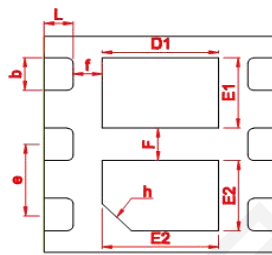
是一款多个TVS合封芯片，小型化的体积方便客户在需要的场合进行应用。

尺寸图

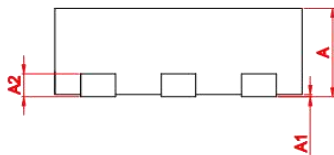
Units: mm



TOP VIEW



BOTTOM VIEW



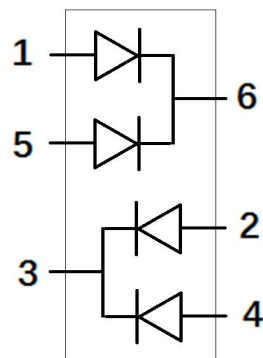
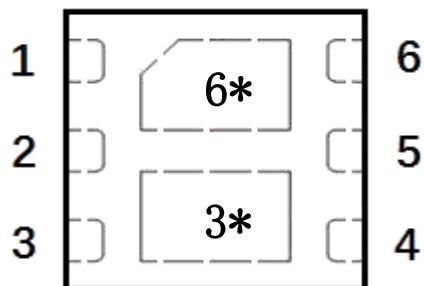
SIDE VIEW

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.700	0.750	0.800
* A1	0.000	0.020	0.050
* b	0.275	0.300	0.325
* A2	0.190	0.210	0.230
* D	1.900	2.000	2.100
* E	1.900	2.000	2.100
* E1	0.570	0.620	0.670
* E2	0.570	0.620	0.670
* D1	0.950	1.000	1.050
* D2	0.950	1.000	1.050
* e	0.600	0.650	0.700
h	0.300	0.350	0.400
* L	0.200	0.250	0.300
* F	0.250	0.300	0.350
* f	0.200	0.250	0.300

特点

- 保护电压：30V
- 温度范围：- 40℃ ~ 105℃
- 低漏电流
- 低钳位电压
- 平面技术制造工艺
- 封装形式：DFN6L

引脚定义



* 衬底2个焊盘分别与对应6和3脚是芯片内部短接的状态，2个衬底也可以作为管脚使用

序号	管脚名称	管脚状态	描述
1	P1		TVS1 P级
2	P2		TVS2 P级
3	N23		TVS2/3 N级
4	P3		TVS3 P级
5	P4		TVS4 P级
6	N14		TVS1/4 N级

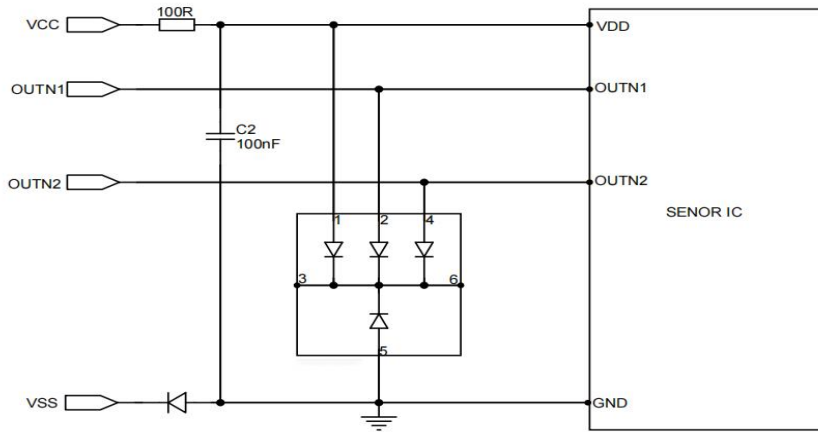
电学特性

(T= 25℃)

符号	参数说明	条件	最小	典型	最大	单位
VCC	供电电压				30	V
IPP	峰值脉冲电流	$t_p=8/20\mu s$		5		A
IR	反向漏电流	$V_{RWM}=30V$		0.1		μA
VRWM	反向工作电压			30		V
VBR	反向击穿电压	$I_T=1mA$	33	36	39	V
VC	钳位电压	$I_{PP}=5A$		50	53	V
		$t_p=8/20\mu s$				
CJ	结电容	$V_{RWM}=0V$ $f=1MHz$		34	40	pF
Top	工作温度		-40		105	℃
Tst	存储温度		-55		150	℃
VESD	空气放电	IEC 61000-4-2		± 30		KV
VESD	接触放电	IEC 61000-4-2		± 30		KV

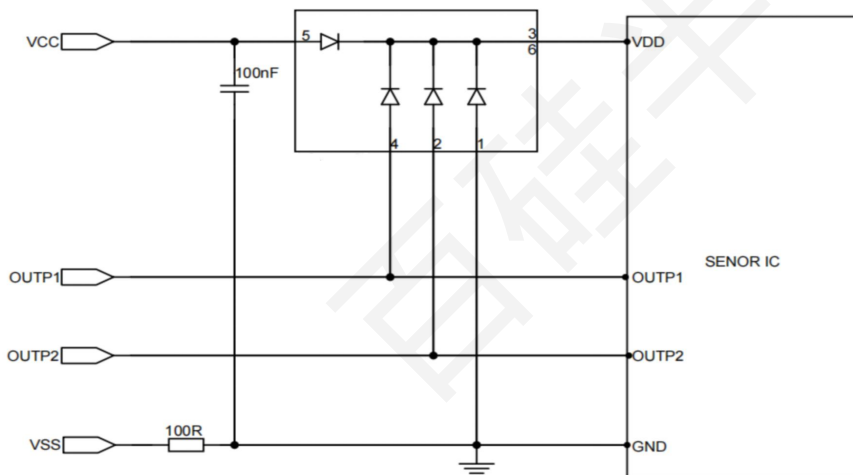
应用电路图:

NPN型



备注:典型应用中3脚与6脚需要短接,
或者直接把2个衬底短接

PNP型



备注:典型应用中3脚与6脚需要短接,
或者直接把2个衬底短接